

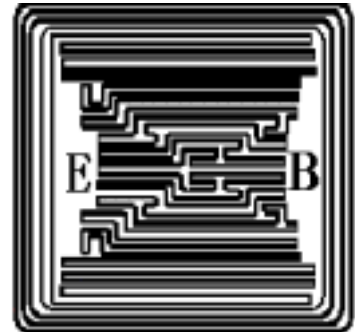


13009 晶体管芯片说明书

芯片简介

芯片尺寸：4 英寸 (100mm)
 芯片代码：D423AG-00
 芯片厚度：240±20μm
 管芯尺寸：4230×4230μm²
 焊位尺寸：B 极 1200×420μm² , E 极 1140×540μm²
 电极金属：铝
 背面金属：银
 典型封装：KSE13009 , HE13009

管芯示意图



极限值 (T_a=25) (封装形式：TO-220)

T_{stg}——贮存温度..... -65~150
 T_j——结温..... 150
 P_C——集电极耗散功率 (T_c=25) 100W
 V_{CBO}——集电极—基极电压..... 700V
 V_{CEO}——集电极—发射极电压..... 400V
 V_{EBO}——发射极—基极电压.....9V
 I_C——集电极电流 (DC)16A
 I_B——基极电流.....6A

电参数 (T_a=25) (封装形式：TO-220)

参数符号	符号说明	最小值	典型值	最大值	单位	测试条件
BV _{CEO}	集电极—发射极击穿电压	400			V	I _C =10mA , I _B =0
I _{EBO}	发射极—基极截止电流			1	mA	V _{EB} =9V , I _C =0
h _{FE}	直流电流增益	10		40		V _{CE} =5V , I _C =5A
		6		30		V _{CE} =5V , I _C =8A
V _{CE(sat)}	集电极—发射极饱和压降			1	V	I _C =5A , I _B =1A
				1.5	V	I _C =8A , I _B =1.6A
				3	V	I _C =12A , I _B =3A
V _{BE(sat)}	基极—发射极饱和压降			1.2	V	I _C =5A , I _B =1A
				1.6	V	I _C =8A , I _B =1.6A
C _{ob}	共基极输出电容		180		pF	V _{CB} =10V , f=0.1MHz
f _T	特征频率	4			MHz	V _{CE} =10V , I _C =0.5A
t _{ON}	导通时间			1.1	μS	V _{CC} =125V , I _C =8A I _{B1} =-I _{B2} =1.6A
t _{STG}	贮存时间			3.0	μS	
t _F	下降时间			0.7	μS	